








	<h2>SI2302CDS-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2302CDS-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 2.6A SOT23-3</p> <p>Datenblätter:  SI2302CDS-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 632434 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2302CDS-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 2.6A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	632434 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 2.6A (Ta) 710mW (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	710mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	57 mOhm @ 3.6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	850mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.5nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2302CDS-T1-GE3TR

SI2302CDS-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SI2302CDS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2302CDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2302CDS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2302CDS VISHAY VISHAY SOT23-3</p>	 <p>SI2302DC-T1 SILICON SILICON SOT23</p>	 <p>SI2302CDS-T1-GE3. VISHAY VISHAY SOT23-5</p>	 <p>SI2302CDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 2.6A SOT23-3</p>
 <p>SI2302CDS-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 2.6A SOT-23</p>	 <p>SI2302DS VISHAY SI2302DS VISHAY</p>	 <p>SI2302BDS-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p>SI2302CDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 2.6A SOT-23</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI2301BDS-T1	↔ SI2301BDS-T1-E3	⇒ SI2301BDS-T1-E3	D SI2301BDS-T1-GE3	↗ SI2301BDS-T1-GE3
⊣ SI2301CDS	⊛ SI2301CDS-T1-E3	D SI2301CDS-T1-E3	⇒ SI2301CDS-T1-GE3	↗ SI2301CDS-T1-GE3
⊛ SI2301DS	⊣ SI2301DS-E3	⊛ SI2301DS-T1	↔ SI2301DS-T1-E3	↗ SI2301DS-T1-GE3
D SI2302ADS	⊛ SI2302ADS-T1	⊣ SI2302ADS-T1	⊛ SI2302ADS-T1-E3	↗ SI2302ADS-T1-E3
⇒ SI2302ADS-T1-GE3	↔ SI2302ADS-T1-GE3	⊛ SI2302BDS-T1-E3	⊣ SI2302CDS-T1-E3	↗ SI2302CDS-T1-E3
↔ SI2302CDS-T1-GE3	⇒ SI2302DDS-T1-GE3	D SI2302DDS-T1-GE3	⊛ SI2302DS	⊣ SI2302DS-E3
⊛ SI2302DS-T1	D SI2302DS-T1-E3	⇒ SI2302DS-T1-GE3	↔ SI2302DV	↗ SI2302WCB
⊣ SI2303ADS-T1-GE3	⊛ SI2303BDS	↔ SI2303BDS-T	⇒ SI2303BDS-T1	↗ SI2303BDS-T1
⊛ SI2303BDS-T1-E3	⊣ SI2303BDS-T1-E3	⊛ SI2303BDS-T1-GE3	D SI2303BDS-T1-GE3	↗ SI2303BDS/A5
↔ SI2303CDS	⊛ SI2303CDS-T1-E3	⊣ SI2303CDS-T1-E3	⊛ SI2303CDS-T1-GE3	↗ SI2303CDS-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited